

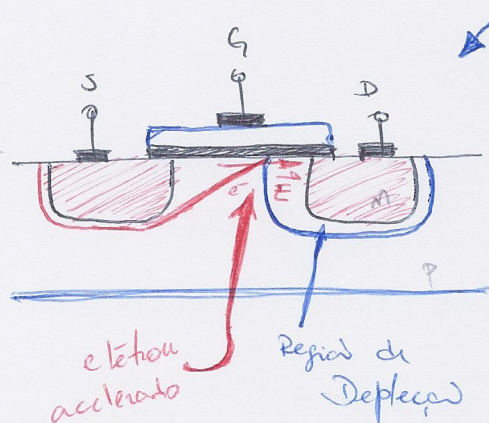
→ Com a variação da densidade de elétrons no canal, devido a variação da tensão V_{GS} , podemos visualizar que existe um valor de V_{GS} para o qual a tensão gate-substrato nas proximidades

lembre-se que V_{TH} garante apenas o início de inversão do canal.

→ do dreno será igual a V_{TH} .

Diremos então, que o canal está estrangulado (pinch-off)

→ Supondo aumentar ainda mais V_{GS} , o ponto de estrangulamento se desloca ainda mais em direção à fonte.



Nessa situação, uma região de depleção será formada ao redor do dreno (entre o dreno e o canal) e deverá suportar todo o excesso de tensão em relação a $V_{GS} - V_{TH}$. fazendo com que os elétrons sejam acelerados em direção ao dreno, tal como na junção BC (TBJ)

